【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第３区分
【発行日】平成25年3月28日(2013.3.28)

【公開番号】特開2011-243149(P2011-243149A)
【公開日】平成23年12月1日(2011.12.1)
【年通号数】公開・登録公報2011-048
【出願番号】特願2010-117260(P2010-117260)
【国際特許分類】
Ｇ０６Ｆ　21/75　　(2013.01)
Ｇ０６Ｆ　21/62　　(2013.01)
【ＦＩ】
Ｇ０６Ｆ　12/14　　５６０Ｅ
Ｇ０６Ｆ　12/14　　５３０Ｄ

【手続補正書】
【提出日】平成25年2月8日(2013.2.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項２】
前記所定の正規メモリセルは、不良メモリセルであり、
前記冗長メモリセルは、前記不良メモリセルに本来格納されるべき、秘匿を要するデータを記憶する、請求項１記載の半導体装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３３】
正規メモリセルアレイ５５は、行列状に配置された複数個の正規メモリセルを含む。正規メモリセルアレイ５５は、仮想不良メモリセル行５６を含む。出荷前のテスト時に、正規メモリセルアレイ５５内の１つの行をランダムに選択し、その選択された行が仮想不良メモリセル行５６に設定される。仮想不良メモリセル行５６のすべての仮想不良メモリには、テスタによって、ドントケア（don't care）値、つまりダミー値が書込まれる。あるいは、仮想不良メモリセル行５６の一部の仮想不良メモリのみ、テスタによって、ドントケア（don't care）値、つまりダミー値が書込まれるものとしてもよい。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４５】
正規メモリセルアレイ６６は、行列状に配置された複数個の正規メモリセルを含む。正規メモリセルアレイ６６は、不良メモリセル行１６と、２つの仮想不良メモリセル行６８，６７を含む。出荷前のテスト時に、正規メモリセルアレイ６６内の不良な行を発見して、その行が不良メモリセル行１６に設定される。また、出荷前のテスト時に、正規メモリセルアレイ６６内の２つの行をランダムに選択し、その選択されたそれぞれの行が仮想不

良メモリセル行６８，６７に設定される。仮想不良メモリセル行６８，６７には、それぞれテスタによって、ドントケア（don't care）値、つまりダミー値が書込まれる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５９】
冗長メモリセルアレイ８５は、３個の冗長メモリセル行５，８３，８４を含む。
冗長メモリセル行５のメモリセルは、アドレスの順序に従えば不良メモリセル行１６に本来格納されるべき秘匿を要するデータを記憶する。冗長メモリセル行８３，８４には、出荷前のテスト時に、テスタによって、ドントケア（don't care）値、つまりダミー値が書込まれる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７１】
ＣＰＵ３は、ユーザから指定された仮想不良メモリセル行のロウアドレスをレジスタ９５へ記憶する。また、ＣＰＵ３は、ドントケア（don't care）値、つまりダミー値のライトデータＤＩをライト／リード回路１５に与えて、レジスタ９５に記憶されたロウアドレスで示される仮想不良メモリセル行のすべての仮想不良メモリセルに、ドントケア（don't care）値を書込む。あるいは、ライト／リード回路１５は、レジスタ９５に記憶されたロウアドレスで示される仮想不良メモリセル行の一部の仮想不良メモリセルに、ドントケア（don't care）値を書込むものとしてもよい。